CLIPFEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT -IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

MANUFACTURE OF S	RE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	□ <u>JP59208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12;H01L21/56;H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE: To obtain a semicondt wherein the semiconductor device substrate is selectively removed b CONSTITUTION: Au plating 12 of of 35mum thickness. A semicondu 11i. The transfer-molding with eposolution from the back surface 11a 12c and the heat radiation surface soldered to a conductor pattern on an easy and simple method.	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.  CONSTITUTION:Au plating 12 of 1 mum thickness, Ni plating 13 of 1 mum thickness and Au plating 14 of 3 mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35 mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1 mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCi3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.  Data supplied from the esp@cenet database - 12

DEST AVVILABLE COPY

secondly the quartous plate 1 to mero the wax i and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with 12 cleaning removed. It wishes the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

Charles AMI Charles In Table

#### 19 日本国特許庁 (JP:

独特商出願公開

### 12 公開特許公報 :A

四召60-10756

5i Int Cl \* H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43 公開 - 83和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

34ビームリート型半導体装置の装造方法

21.14

劉 昭58 119143

22出

類 7858(1983)6月30日

72発 明 者 鞭卷系雄

東京都港区芝五丁[133番1号] 本電気株式会社内

五出三願三人。日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

多代 理 人 弃理士 内原管

明 網 各

#### 1. 発明の名称

ビースリード型半週体装貨の製造方法

#### 2. 特別無米の判据

ビームリード型半導体を子の形成されたウェハーを裏返してファクスで平板に貼り付ける工程と、 前配ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去 してペレットに分離する工程と、前配ファクスを 高しペレット吸制用始具にて前配平板から前配ペ レットを分限する工程と、前配ペレットに付着し ているファクスを、暖められた低が用受け皿内に て、暖めた有機高調によってリックスを除去する 工程とを含むことを前なとするビームリード型半 連体振行の製造方法。

#### 3 M. W. C. L. C. C. C. C. C. C.

本限的は日→スリードが生物体を作の参照方法 は独立る。 従来ビーエリード型半導体装置の製造方法は、 所別のビーエリード型半導体製子の形成された半 導体系板の上面にリックスを患布し石莢板と貼り 合せし後、無半導体状板の更新にレジストにてパ ターンを形成し机能能で半薄体のマハーを選択的 にエッチンク終去してペレットと他分割し、たいペレット1個でつかばして再配列する力に100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスをだ しペレット数が用的具にてペレットと石莢がとを 分割後、半導体ペレットに付着ワックスをデわか 無ヒーターで有機器割を除めた有機器割をスプレーガンで3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に がべていた。

しかし上記算者のペレットハンドリングデサビ は、以下に述べるような欠かがあった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 変質とがウェクスによって助り合わさってかりと のウェクスを100~200 じの配面のホットブレ ート上で石裏板と切れてフェクスを描かし、ベレ ェトのポリー月にてベレットと石裏板とを分配は、

- 2 -

半海はペレットの配動面がび其北に付着している ワックスを、50~100℃の解車動件のが終セ ーターにて予め有機用型を繋めスプレーガンで吹 付料30~35℃範囲の有機容割を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの前向市及び終記にワックスが残っていると、ベレットの何折当及び歩割りを取りし込ベレットサイズによってベレットハンドリングの 洗浄的間を扱くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

一本契明は上制的点を終去し半導体装飾の保育性 及び製造事業とを大幅に同由させることのできる 単調体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体数子の 形成されたウェハーを表落してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを提問から退 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

似する。

次には3回に示すようにペレット15の配線所及び製師に付加しているファクス13を50~
100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予め有機を削と、洗作用で取186加熱ヒーター
19によって50~100での減度範囲で加熱し、スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有機を測を3~4秒間吹付けてファクスを除去した。(第4回)後、別の配列数と2上にペレット15を配列する。

上記のように本住明万法によればペレットの配 報備及び州部に付押しているワックスを予め殴り た有機冷制と庇伊州受け期もWわふことにより有 機管制を結ねでペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが原去でき、しかもペレットにワックスが絞ることなく、剝鉛歩値り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 観像なく短時間でペレットパンドリングが可能に なる。

4. 図前の酵母な砂切

群と、か新によりフェックタをもしていって外の中 おねにでもないられなってもながするよりで、 前記のレートにいかしているリックスを、既めら の大量は回四には、眺めたお梅前期にて除去する 工程と、前かペレットを配列する工程とを含む出 身体報をの製作力がある。

以下更新例が見づき四面を対例して年齢期を計 動化初期する。

まず他)はに・するかは、必知のビースリード 動ま子の形成された単導体ウェバー」を、前がビ ーエリードでが下にかるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数4に辿り付ける。

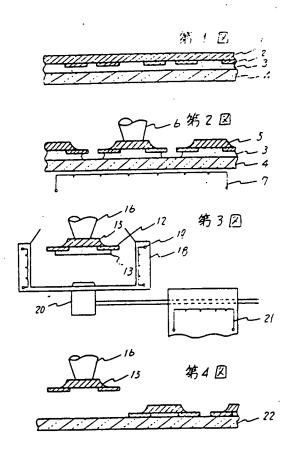
がに前続け点はドェハー1の毎回にレジストバターンを単形し、マバターンをマスクにして存作数を用いて数でェハーを選択的にエッテンク所テし、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのホットブレート7の上で石姿収4を望めてワックス3を結かしペレット所
常用的具6を用いてペレット5を石英板4から分

無1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断菌器である。

1 ……半初体ウェハー、2.12……ビームリード、3.13……ワックス、4……石灰板、5.15……ベレート、6.16……ベレット吸石用 竹具、7……ホットブレート、18……旅布用受け皿、19……旅作用受け皿の加熱ヒーター、 20……スプレーガン、21……有概形態の加熱 ヒーター、22……ガラス似てある。

代野人 养野士 一円 原

, factories to to fine



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.